SF₆ガス/固体ハイブリッド絶縁による GIS小形化技術

釣本崇夫* 山本茂之** 吉村 学** 海永壮一朗**

Down-sizing of Gas Insulated Switchgear with SF₆ Gas/Solid-hybrid Insulation Takao Tsurimoto, Manabu Yoshimura, Soichiro Kainaga, Shigeyuki Yamamoto

要 旨

ガス絶縁開閉装置(GIS)には、高い絶縁性能を持つSF。 (六フッ化硫黄)ガスが絶縁媒体や消弧媒体として使用され ている。しかし、SF₆ガスは地球温暖化係数が高いため、 世界規模での環境意識の高まりの中でガスの使用量や排出 量の削減といった低環境負荷への対応が求められている。

これに対して,三菱電機ではガス絶縁性能を更に向上さ せて機器を小形化するためのハイブリッド絶縁技術を開発 した。ハイブリッド絶縁は,高電圧導体表面に固体絶縁被 覆を施したもので,ガス絶縁で弱点となる電極表面上を絶 縁物で覆うことで放電を抑制するものである。これによっ て,導体を被覆しない場合に比べて絶縁性能を50%向上させた。また,放電が発生して絶縁破壊するまでのプロセスを放電光の観測によって明らかにし,絶縁性能のばらつきが小さく信頼性の高い絶縁被覆を実現した。

この方式を550kV GISの変流器(Current Transformer: CT)部の導体に適用することで,接地電位となるCT収納 ケースを小形化し,CT本体及びタンクの小形化とSF₆ガス 使用量の30%削減を実現した。今後,ハイブリッド絶縁の 適用範囲を拡大することによって,GISの一層の小形化を 図る。



ハイブリッド絶縁によるSF。ガス絶縁性能の向上と550kV GISへの適用

金属電極に絶縁被覆をしない従来のSF®ガス絶縁に対して、絶縁被覆したハイブリッド絶縁の破壊電界は50%上昇する。ハイブリッド絶縁 では、放電がガス空間を起点に発生して絶縁破壊する様子が確認でき、電極表面の微小突起など絶縁上の弱点の影響が抑制されるためと推定で きる。550kV GISのCT部の導体を絶縁被覆してハイブリッド絶縁にすることで高電界絶縁設計を可能とし、CT本体とCTタンク径の小形化を 実現した。

1. まえがき

ガス絶縁開閉装置(Gas Insulated Switchgear:GIS)は 高電圧導体を絶縁特性の優れた六フッ化硫黄(SF₆)ガスが 充填されたタンク内にコンパクトに配置した電力用の開閉 装置である。GISのタンク径はガス絶縁設計と熱設計で決 まる。このうち,絶縁設計については高ガス圧化等による 高電界化が進められてきたが,既に限界に達しつつある状 況である。

一方,高電圧導体の表面に絶縁物を被覆し,SF₆ガス絶縁 と固体絶縁を複合させたハイブリッド絶縁にすることで, SF₆ガスの絶縁破壊電界が高くなることが知られている⁽¹⁾。 この理由は次のように解釈される⁽¹⁾。金属導体の表面には µmオーダーの微小な突起が存在しているため,ガス空間 には局部的に電界が集中し,この部位が放電の起点となる。 導体面積が大きくなるに従い絶縁破壊を引き起こす微小突 起の存在確率が高くなるため,破壊電界は低下する。これ に対して,導体表面が絶縁被覆されていると,金属の微小 突起によるガス空間の電界集中が生じなくなるため,破壊 電界は上昇するのである。大面積領域(例えば実際のGIS の導体面積)では破壊電界の低下が大きいため,絶縁被覆 の効果は大きくなる。

当社はハイブリッド絶縁を実器に適用するため,厚膜の 絶縁被覆形成が可能な樹脂注型による導体被覆⁽²⁾や,金型 が不要で導体の形状に合わせてフレキシブルに被覆形成が 可能な絶縁薄膜コーティング⁽³⁾による破壊電界上昇効果の 確認を実器規模で行い,また,原理検証を進めてきた。

本稿では、当社が開発したSF₆ガス/固体ハイブリッド 絶縁技術について述べる。

2. ハイブリッド絶縁による破壊電界上昇

2.1 絶縁被覆形成方法

導体に絶縁被覆を形成する方法として、樹脂注型と樹脂 コーティングについて開発を行ってきた。樹脂注型は、厚 膜形成が可能であるため被覆そのものの貫通耐電圧を高く でき、また、絶縁被覆が電圧の一部を分担するため電界不 平等性の高い電極表面に適用するとガス空間の電界集中を 緩和できるという利点がある。一方、被覆するためには金 型が必要であるため、導体のサイズや形状などに制約があ る。これに対して、樹脂コーティングは被覆厚さが薄くな るが、この制約を受けずに被覆できる方法である。ここで は樹脂コーティングで被覆を形成した薄膜ハイブリッド絶 縁の破壊電界上昇効果について述べる。

2.2 破壊電界の上昇

図1に薄膜ハイブリッド絶縁の試験電極系を示す。高電 圧電極としてアルミニウム製のリング形状の電極を用い, 表面には厚さ数100µmの絶縁被覆をコーティングによって 形成した。この電極を円筒タンク内に同軸に配置し、タン ク内に所定のガス圧力のSF₆ガスを充填した。高電圧電極 の最大電界に対して95%以上高い領域を電界解析によって 求め、この面積を電極の有効面積とした。電極有効面積は リング形状の電極の数で変化させた。なお、ガス空間にお ける電界の不平等性を示す電界利用率は0.58である。

印加電圧として負極性の雷インパルス電圧を用い,絶縁 破壊するまで段階的に電圧を上昇させる昇圧法によって破 壊電圧を測定した。絶縁被覆はガス空間で絶縁破壊すると 同時に貫通破壊するため,その都度電極を交換しながら条 件ごとに10点の破壊電圧を取得した。

図2にガス圧力0.4MPa・abs(絶対圧)における絶縁破壊 電圧のデータに基づき算出した絶縁破壊確率が0.1%にな る電界(以下"0.1%破壊電界"という。)と電極有効面積との 関係を示す。電界はSF₆ガス0.4MPa・absでの臨界電離電 界を基準(1.0p.u.)とした。

図2から,絶縁被覆していない裸電極の場合は電極有効 面積が増加するにつれて絶縁破壊電界が低下することが分 かる。特に実器設計上重要な面積10⁵mm²以上の領域では, SF₆ガスの臨界電離電界に対して破壊電界は64%に低下し た。一方,樹脂コーティングによって絶縁被覆した電極の 場合は,電極有効面積が大きくなるにつれて破壊電界が低 下する現象が改善され,10⁵mm²以上の領域で臨界電離電 界に対して破壊電界は89%であった。つまり,被覆によっ て破壊電界は40%上昇した。



図2. 薄膜ハイブリッド絶縁による破壊電界の電極面積依存性 (ガス圧力0.4MPa・abs)



図3. 薄膜ハイブリッド絶縁による破壊電界のガス圧力依存性 (電極有効面積10⁵mm²以上)

図3に電極有効面積10⁵mm²の領域における0.1%破壊電 界のSF₆ガス圧力依存性を示す。裸電極での破壊電界はガ ス圧力とともに上昇するものの、その上昇率はガス圧力が 高いほど鈍くなり、ガス圧力の0.7乗に比例する結果が得 られた。一方、被覆電極での破壊電界はガス圧力に対して 0.85乗に比例した。この指数が示すように、ガス圧力が高 いほど絶縁被覆による破壊電界の上昇効果は大きくなり、 0.6MPa・absでは破壊電界は50%上昇した。

この結果から、薄膜ハイブリッド絶縁はGISの設計電界 を飛躍的に高くできる優れた技術であるといえる。

3. 破壊電界上昇のメカニズム

3.1 ストリークカメラによる放電光の観測方法

ハイブリッド絶縁によって破壊電界が上昇する理由は1 章で述べたが、これまで放電を直接観測して論じられた例 はなかった。そこで、nsオーダーの非常に短い時間で完 結する放電に対して、放電光が発生してから絶縁破壊する までの様子をストリークカメラ(NAC社、ULTRANAC FS-501)で直接観測し、破壊電界が上昇するメカニズムを 明らかにした。

図4に放電光観測の試験電極系を示す。被覆電極として, 真空注型によってエポキシ樹脂を被覆したアルミニウム製 の半球電極を用いた。被覆の厚みは2mm又は4mm,電 極の半径は被覆を含めて10mmとした。また,裸電極とし て半径10mmのアルミニウム製の半球電極を用いた。これ らの高電圧電極に対向して平板の接地電極を配置し,ガス 空間距離は5mmとした。この電極系におけるガス空間の 電界利用率は0.74~0.77である。試験電極系をタンク内に 設置して所定のガス圧力のSF₆ガスを充填した。負極性の 雷インパルス電圧を繰り返して印加し,絶縁破壊時の放電 光をストリークカメラで観測した。

3.2 放電進展プロセス⁽⁴⁾

図5に裸電極で観測されたストリークカメラの典型的な 画像と、画像から推測される放電の挙動の模式図を示す。

横軸は時間,縦軸は位置を示し,電極先端の位置を破線 で表した。図5から,放電光は高圧電極表面を起点に発生



図4. 放電光観測の試験電極系





図5. 裸電極における放電光の開始と進展



図6. 被覆電極における放電光の開始と進展

し(①),接地電極に向かって進展する過程でガス空間から も新たに放電光が発生し(②),電極間を橋絡した(③)。一 方,被覆電極の典型的な画像を図6に示すが,放電光は電 極近傍のガス空間を起点に発生し(①),被覆絶縁物上でも 放電光が発生し(②),さらに,ガス空間でも発生し(③), これらがつながってガス空間を橋絡し(④),被覆絶縁物上 を放電光が進展して最終的に金属電極間を橋絡して絶縁破 壊へと至った(⑤)。 ◇一般論文◇



図8. 放電光の起点の位置(被覆電極)

ここで,最初に放電光が観測された"起点"に着目し,電 極表面とガス空間のいずれを起点に放電光が発生したかを それぞれの電極系について図7と図8にまとめた。観測数 (N)は各条件でN=5~8点である。図7から,鏡面仕上 げした裸電極ではガス圧力0.3MPa・absで放電光の起点は 電極表面とガス空間がほぼ半々であった。これは,電極が 放電の発生に影響を及ぼしていることを示唆している。ま たガス圧力を0.6MPa・absに高くし,電極表面を粗面仕上 げした場合,放電光は全て電極表面が起点となった。一方, 図8から被覆電極ではガス圧力0.4MPa・absで放電光の起 点は全てガス空間であった。

このように、ストリークカメラによる放電光観測によっ て、図2、図3に示したような電極の絶縁被覆による絶縁 破壊電界の上昇の理由を実験的に裏付けることができた。 つまり、裸電極の場合、電極表面の微小な突起が絶縁上の 弱点として作用するのに対して、被覆電極の場合、電極表 面が絶縁物で覆われることによって弱点として作用しなく なり、ガス空間を起点に放電が起こる。つまり、ガス本来 の絶縁性能が発揮されるようになるのである。

4. GISへのハイブリッド絶縁の適用

図9にハイブリッド絶縁を適用した550kV GISの外観を 示す⁽⁵⁾。主母線に架空線を用いるH-GISと呼ぶタイプであ る。遮断器,断路器,接地開閉器,変流器等は直線上に設 置した。変流器の高電圧導体と変流器収納ケースの間に薄 膜ハイブリッド絶縁方式を適用した。これによって変流器 本体及びタンク径を小形化し,SF₆ガスの使用量を70%に 削減した。



図 9. 550kV GIS

5. む す び

当社が開発したGIS小形化のためのSF₆ガス絶縁と固体 絶縁を組み合わせたハイブリッド絶縁技術について述べた。 当社のハイブリッド絶縁は,従来のガス絶縁に対して破壊 電界が40%以上上昇し,他の報告と比較しても高い絶縁性 能を持っている⁽⁶⁾。この理由は,導体への絶縁被覆によっ てガス空間が放電起点となり,ガス本来の絶縁性能を発揮 できているためであることを,放電光の発生から進展まで の直接観測で明らかにし,実用的な絶縁技術として確立し た。

参考文献

- (1) Honda, M., et al.: Impulse Breakdown Characteristics of Coated Electrodes in SF₆ Gas, IEEE Trans. on Power Delivery, **PWRD-2**, No.3, 699~708 (1987)
- (2) 吉村 学, ほか:SF₆ガス中エポキシ樹脂モールド電 極のフラッシオーバ特性と繰返し放電によるエポキシ 樹脂の貫通破壊特性, 電気学会論文誌B, **134**, No.9, 820~825 (2014)
- (3) 吉村 学,ほか:電極への薄膜絶縁被覆によるSF₆ガ ス絶縁システムの高耐電圧化,平成22年電気学会電 力・エネルギー部門大会,No.326 (2010)
- (4) 海永壮一朗, ほか:SF₆ガス/固体ハイブリッド絶縁
 系における放電起点,電気学会論文誌A, 134, No.4, 285~290 (2014)
- (5) 貞國仁志, ほか:新形ばね操作550kV GIS, 三菱電機 技報, 86, No.9, 490~493 (2012)
- (6) Hama, H., et al.: Cross-sectional Study between SF₆ and Eco-friendly Gases on Dielectric Coated Electrodes for Real-size Gas Insulated Switchgear, IEEE Trans. on Dielectrics and Electrical Insulation, 19, No.1, 253~262 (2012)